

გამოქვეყნებული ნაშრომების სია:

1. Ю.А. Гольдберг, Т.А. Лаперашвили, Г.А. Накашидзе и Б.В. Царенков. Влияние термообработки на характеристики прямой токо-напряжение Au - p - GaP поверхностно-барьерных структур. - Письма в ЖТФ, т. 8, вып.14, 1982, с.886-889.
2. М.В. Бахтадзе, Ю.А. Гольдберг, Т.А. Лаперашвили и Г.А. Накашидзе Влияние термообработки на фотоэлектрические свойства Au - p - GaP диодов Шоттки. - Сообщения Акад. наук Груз. ССР, т.110, № 2, 1983, с.289-292.
3. Бахтадзе М.В., Лаперашвили Т.А. и Сагинашвили И.Н. Фотоэлектрические свойства In - GaP поверхностно-барьерных структур. - Труды Тбилисского ун-та, т.244. 1983. Физика, с. 120-125.
4. Бахтадзе М.В. и Лаперашвили Т.А. Электрохимический метод создания диодов Шоттки на основе GaP. - Известия Акад. наук Груз. ССР, сер. хим., т. 11, № 4, 1985, с.306-308.
5. Лаперашвили Т.А. и Накашидзе Г.А. Зависимость высоты барьера Шоттки структур с олупроводниками на основе GaP от электроотрицательности металла. - Журнал технической физики, т.55, вып.4, 1985, с.733-734.
6. Ю.А.Гольдберг, Т.А.Лаперашвили и Г.А.Накашидзе. Изменение механизма прохождения тока при переходе барьерного контакта к омическому вследствие отжига структуры Au-GaP p- типа. - В кн.: Оптическая обработка информации и оптоэлектроника. /Ред.Д.Г.Саникидзе/. Тб., "Мецниереба", 1986. с.51-55 (Акад.наук Груз.ССР. Ин-т кибернетики).
7. Э.Р. Кутелия, О.А. Глонти, И.Н. Сагинашвили, Т.А. Лаперашвили и Г.А. Накашидзе. Исследование структурного несовершенства поверхности фосфида галлия. - Поверхность: Физика, химия, механика, № 2, 1986, с.61-64.
8. Лаперашвили Т.А. и Накашидзе Г.А. Спектральные характеристики диодов Шоттки полученных электрохимическим осаждением металлов на фосфиде галлия. - В кн.: Тезисы докл. У1 Респ.. коллокви. по оптике и спектроск. полупр. и диэлектр. /г.Сухуми, 18-23 мая/. Тб., "Мецниереба", 1987, с.137-138.
9. Лаперашвили Т.А. Механизм формирования и свойства потенциального барьера на границе раздела фосфид галлия-металл. Автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. физ.-мат. наук. Тб., 1989. 23 с.
10. მ.ბახტაძე, თ. ლაფერაშვილი, ა.მუმლაძე და ი. საგინაშვილი გალიუმის ფოსფიდზე მეტალების ელექტროქიმიური დაფენით მიღებული შოტკის დიოდების ელექტრული თვისებები. - საქ. მეცნ. აკად.მაგნე, ქიმიის სერ., ტ.17, N 4,1991, გვ.253-258.
11. ლაფერაშვილი თ. და ჯიბლაძე რ. ფოტოფექტი In/GaP შოტკის დიოდში. - საქ. მეცნ. აკად. მოამბე. ტ.141,N 1,1991, გვ.81-84.
12. ლაფერაშვილი თ. შოტკის ბარიერის ბუნება კონტაქტში გალიუმის ფოსფიდი-მეტალი. - საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, ტ.141, N 3, 1991, გვ.513-516.
13. ლაფერაშვილი თ. ლითონ-ნახევარგამტარის კონტაქტი (შოტკის ბარიერი). - თბილისის უნ-ტის შრომები, ტ.306, 1991, გვ.185-202.
14. ლაფერაშვილი თ. და ფასურიშვილი დ. ომური კონტაქტი გალიუმის არსენიდზე. - საქ.მეცნ.აკად.მოამბე, ტ.152, N 2, 1995, გვ.269-273.
15. ლაფერაშვილი თ. ლაფერაშვილი დ. „ომური კონტაქტის ფორმირების მექანიზმი A3 B5 ჯგუფის ნახევარგამტარებზე“. - მეცნიერება და ტექნიკა, N 7-9, 2000, გვ.48-52.
16. თ.ლაფერაშვილი, მ. ბახტაძე, გ. ჯორჯიშვილი, ნ. გაბრიაძე და ი. კახაბრიშვილი. მეტალის ელექტროქიმიური დაფენით მიღებული შოტკის კონტაქტები.- საქ. მეცნ. აკად. მაგნე, ქიმიის სერ., ტ.26, N1-2, 2000, გვ. 160-164.

17. М.Г. Кекуа, Г.Ш. Дарсавелидзе, Ц.Т. Циклаური, К.С. Бердзенишвили, Г.И. Джишқариани, Л.З. Квиникадзе и Т.А. Лаперашвили. Омический контакт сложнолегированным твердым раствором на основе $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$. - В кн.: Термоэлектрики и их применения. Доклады У11 Межгос. семинара, Ноябрь 2000 г. Санкт-Петербург, 2000, с. 186-187.
18. Laperashvili T. and Imerlishvili I. Electrochemically deposited Shottky barrier height. - Proceedings Institute of Cybernetics, vol. 1, N 1-2, 2000, p.208-211.
19. ლაფერაშვილი თ., იმერლიშვილი ი. ქობლადე ზ. პროგრამა „გადამრჩველი“, საქ. მეცნ. აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის შრომები, პროგრამული პროექტები 2000წ.
20. ლაფერაშვილი თ და ლაფერაშვილი დ. კონტაქტური წინაღობის გაზომვა. - მეცნიერება და ტექნოლოგიები, # 7-9, 2001, გვ. 26-30.
21. ლაფერაშვილი თ და ბახტაძე მ. მეტალისა და ნახევარგამტარის ომური კონტაქტი. - საქ. მეცნ. აკად, მაცნე, ქიმიის სერ., ტ.27, N# 3-4, 2001, გვ
22. Laperashvili T. The Possibility of Electrochemically Deposition of Al from aqueous salt-solution on the Semiconductors A3B5. Proceedings Institute of Cybernetics, vol.2, N 1-2, 2002, p.208-211. (Georgian Acad. of sciences).
23. Laperashvili T. and Khachidze M. The Properties of SD Obtained by Electrochemical Deposition of Al on Semiconductors. Georgian Engineering News, N 2002, N4, pp. 75-78.
24. T. Laperashvili, M. Khachidze, I. Imerlishvili, Electrochemical deposition of Al on semiconductors, Proc. SPIE 4936, Nano- and Micro technology: Materials, Processes, Packaging, and Systems, 349, 2002; DOI: 10.1117/12.469746.
25. T. Laperashvili, I. Imerlishvili, M. Khachidze, D. Laperashvili, Photoelectric characteristics of contacts In/Semiconductor A3B5, Nanotechnology, Proc. of SPIE Vol. 5118, p.502-506, 2003.
26. Laperashvili T. Imerlishvili I, T. Kaldani, N. Macharadze. Investigation of Semiconductors Conduction Band Structure from I-V and C-V Measurements on Schottky Diodes - Proceedings Institute of Cybernetics, vol.3, N 1-2, 2002 p. (Georgian Acad. of sciences).
27. Laperashvili T., Imerlishvili I., Laperashvili D. Surface-Barrier Sensor Based on the GaP Schottky contact, Georgian Engineering News, N3, pp.64-70 2004,
28. თ. ლაფერაშვილი, დ. ლაფერაშვილი, ი. იმერლიშვილი, ნ. ქალდანი. III-V ნახევარგამტარებზე მეტალების ქიმიური და ელექტროქიმიური დაფენით მიღებული სტრუქტურების ფოტო-ელექტრული მახასიათებელი, კრებული „კონფერენციის მასალები ფოტონიკა 2005“, (მთ. რედაქტორი: აკად. ვ. ჭავჭავანიძე), გვ. 54-70, თბილისი 2005
29. Laperashvili, T.A., Kaldani, N.R., Laperashvili, D.L., Optoelectronic switch device based on GaP. Georgian Engineering News N 3, pp. 67-70, 2006.
30. ლაფერაშვილი თ.ა., ინჟექციური კონტაქტები გალიუმის ფოსფიდზე. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2007
31. T. Laperashvili, V. Mikelashvili, O. Kvitsiani, Laperashvili Davit. Electrical Characteristics of Fe/GaAs Structures. Georgian Engineering News. 2008წ. 4, 23-26.
32. კვიციანი ო., ლაფერაშვილი თ., მარხულია ჯ., ნაკაძე თ., ნაკაშიძე გ., კომპენსირებული გალიუმი სფოსფიდის ბაზაზე შექმნილი დიოდის ელექტრული და ფოტოელექტრული მახასიათებელი; კერამიკა (საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი), 1-2(20-21). გვ. 204-208, 2009.
33. T. Laperashvili, O. Kvitsiani, Laperashvili Davit, Imerlishvili Ilia. Ferromagnetic Metal/GaAs Heterostructure. New Development in Material Science (eBook). NOVA Publisher. 2010წ. ISBN: 978-1-61668-907-0.

34. T. Laperashvili, O. Kvitsiani, Imerlishvili Ilia, Lapherashvili Davit. Terahertz pulse detection by the GaAs Schottky diodes. Proceedings of SPIE, Nonlinear Optics and Applications IV. 2010წ. 7728.
35. თ.ლაფერაშვილი, გალიუმის არსენიდზე ლითონების ქიმიური და ელექტროქიმიური მეთოდით დაფენა, ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა (საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“), 2011, გვ. 78-91
36. თ.ლაფერაშვილი, ი.იმერლიშვილი, ლითონისა და ნახევარგამტარის კონტაქტის გამოყენება ნახევარგამტარული მასალის პარამეტრების შესასწავლად, ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა (საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“), 2011, გვ. 92-108
37. თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი, ჯ. მარხულია, გულიაშვილი თამარ, ლაფერაშვილი დავით. ომური კონტაქტები – III-V ჯგუფის ნახევარგამტარებზე. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010 წ. 10-12, 9-15.
38. თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი, ვ. მიქელაშვილი, ჯ. მარხულია, ლაფერაშვილი დავით, იმერლიშვილი ილია. კვანტურწერტილოვანი ნანოსტრუქტურების მიღება III-V ნახევარგამტარებზე III ჯგუფის მეტალების დაფენისა და თერმოდამუშავების საშუალებით. ნანოქიმია – ნანოტექნოლოგიები. 2010 წ. ISBN: 978-9941-416-34-7, 193-198.
39. თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი. შოტკის ბარიერის ფორმირების მექანიზმები III-V ნახევარგამტარებზე და დიოდების ფიზიკური მახასიათებლები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2011წ. 7-9, 8-16.
40. ლაფერაშვილი თ. გალიუმის არსენიდზე ლითონების ელექტროქიმიური დაფენის გაუმჯობესებული ტექნოლოგია; ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა (საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“), 2011, გვ. 3-17.
41. ლაფერაშვილი თ., კომპენსირებული ნახევარგამტარების ფოტოგამტარობა; ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა ((საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“), 2011, გვ. 138-154.
42. T. Laperashvili, O. Kvitsiani, Lapherashvili Davit, Imerlishvili Ilia. Optical Switching Mechanism in Double Injection GaP Devices. Georgian Engineering News. 2011წ. 2, 94-100.
43. თ.ლაფერაშვილი, ო.კვიციანი, დ.ლაფერაშვილი ი.დლონტი. თერმოდამუშავების გავლენა ნახევარგამტარისა და ლითონის კონტაქტის ფოტოელექტრულ მახასიათებელზე, ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა ((საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“), 2011, გვ. 121-130
44. თ.ლაფერაშვილი, ო.კვიციანი. გალიუმის არსენიდზე შოტკის ბარიერის წარმოქმნის მექანიზმები. ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა ((საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“), 2011, გვ. 109-120
45. T. Laperashvili, O. Kvitsiani, Lapherashvili Davit, Imerlishvili Ilia. The Method of Fabrication and the Properties of GaAs Schottky Diodes. Georgian Engineering News. 2011წ. 2, 101-108.
46. თ. ლაფერაშვილი, ვ. მიქელაშვილი, ო. კვიციანი. გალიუმის არსენიდზე მცირე წინაღობიანი ომური კონტაქტების მიღება და კვლევა. ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა. 2011წ. 121-130.
47. თ.ლაფერაშვილი, დ.ლაფერაშვილი. „ტერაჰერცული სიხშირის გამომცხივებლები და მიმღებები III-V ჯგუფის ნახევარგამტარების კვანტურწერტილებიანი სტრუქტურების ბაზაზე“ ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა. 2011წ. 141-151..
48. ლაფერაშვილი თინათინ, კვიციანი ორესტ, III-V ნახევარგამტარული კვანტურწერტილოვანი სტრუქტურები მესამე თაობის მზის ელემენტებში, 21-ე

- საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, კონფერენციის შრომების კრებული. 2012წ. 2, 229-235.
49. T. Laperashvili, O. Kvitsiani, M. Elizbarashvili, A. Chanishvili, Lapherashvili Davit. Nanotechnology and semiconductor devices. Nano Studies. 2014წ. 10, 83-88.
 50. V. Mikelashvili, T. Laperashvili, O. Kvitsiani, Lapherashvili Davit. Solar cells based on InP/GaP/Si structure. Proceedings of SPIE, Optoelectronic Devices and Integration VI, 100191G. 2016წ. 10019.
 51. T. Laperashvili, A. Chanishvili, Lomitashvili Shorena. Indium Phosphide Quantum Dots on Gallium Phosphide (Fabrication methods) . Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical Series. 2016წ. 43, 4, 512-515.
 52. D. Laperashvili , T. Laperashvili , A. Chanishvili, InP Based Nanomaterials For Telecommunications, Nano Studies, 13, 241-246. 2016,
 53. თ. ლაფერაშვილი შ. ლომიტაშვილი, ალუმინის ელექტროქიმიური დაფენა გალიუმის არსენიდზე, საქ. მეცნ.აკად. მაცნე, ქიმიის სერია ტ.41, #4 2014.
 54. თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი, მ. ელიზბარაშვილი, ლაფერაშვილი დავით. ულტრაისფერი გამოსხივების მავნე ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და UV ნახევრადგამტარიანი დოზიმეტრი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2014წ. 3(717), 76-80.
 55. T. Laperashvili, O. Kvitsiani, M. Elizbarashvili. Nanostructured III-V Semiconductor solar cells. Georgian Engineering News. 2014წ. 4, 29-34.
 56. T. Laperashvili, O. Kvitsiani. III-V Semiconductor Nanostructure for Solar Cells. Nano Studies. 2016წ. 14, 239-244.
 57. T. Laperashvili, O. Kvitsiani, D. Lapherashvili, InGaP Nanostructured layer on GaP surface, SPIE Photonics Europe, Strasbourg, France. Paper 10672-143 [გადაცემულია დასაბეჭდად]
 58. Laperashvili T.A., Kvitsiani O.R. and Lapherashvili D.L., Fabrication of InP nanostructured layer on GaP surface, Georgian Engineering News, 85, 1, 34-38 (2018).
 59. თინათინ ლაფერაშვილი, ორესტ კვიციანი, ფოტოვოლტური მზის ელემენტების ეფექტიანობის გაზრდის გზები, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2, 33-45 (2018)